

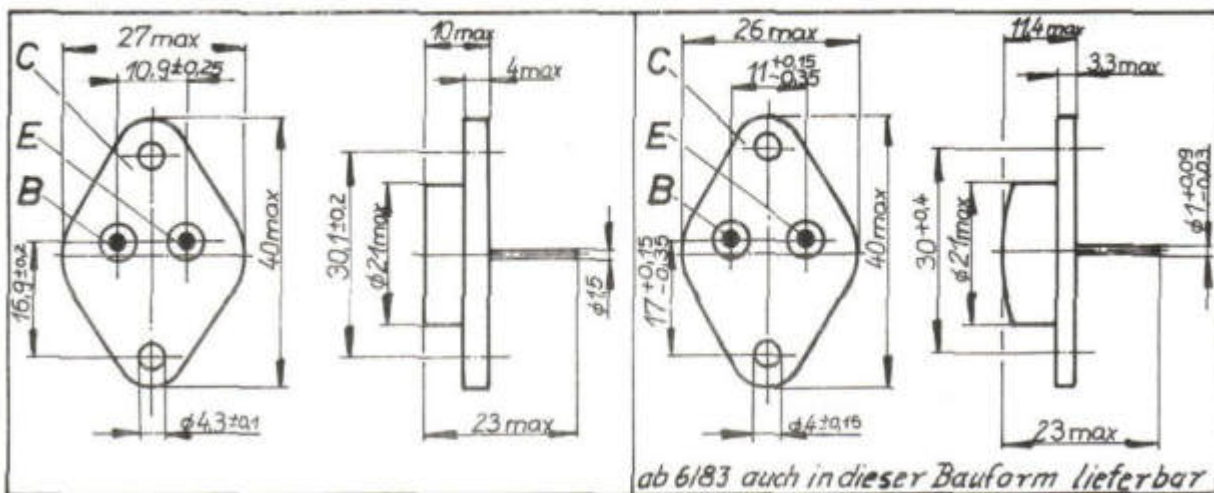
SU 165

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Transverter, Schaltnetzteile und allgemeine Anwendung.

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g

Kollektor am
Gehäuse



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung

$R_{BE} \leq 100 \Omega$

U_{CERM}

900 V

Kollektor-Emitter-Spannung

$I_B = 0$

U_{CEO}

350 V

Kollektorstrom

I_C

2,5 A

Kollektorspitzenstrom

I_{CM}

3,0 A

Basisstrommittelwert

$I_{B(AV)}$

1,5 A

Basisspitzenstrom

I_{BM}

2,5 A

Gesamtverlustleistung

$\vartheta_c \leq 90^\circ\text{C}$

P_{tot}

10 W

Sperrschichttemperatur

ϑ_j

+ 115 °C

Betriebstemperaturbereich

ϑ_a

+ 100 °C

Kennwerte, bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$

		min	typ	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 900\text{V}$	I_{CES}			1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 1\text{A}, I_B = 0,2\text{A}$	U_{CEsat}			3,0 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 1\text{A}, I_B = 0,2\text{A}$	U_{BEsat}			1,5 V
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $U_{CE} = 5\text{V}, I_C = 0,5\text{A}$	h_{21E}	5		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{mA}$	$U_{(BR)CEO}$	350		V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{mA}$	$U_{(BR)EBO}$	4		V
Einschaltzeit des Kollektorstromes $I_C = 1\text{A}, I_B = 0,2\text{A}$ $-I_B = 0,4\text{A}$	t_{on}			1,0 μs
Ausschaltzeit des Kollektorstromes	t_{off}			5,0 μs

Bestellbezeichnung: Transistor SU 165
Änderungen vorbehalten!

Information 0682



**veb gleichrichterwerk
stahnsdorf**
im veb kombinat mikroelektronik

DDR 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telex 015220 Telefon 680

elektronik
export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie
Telefon: 2180 · Telex: 114721